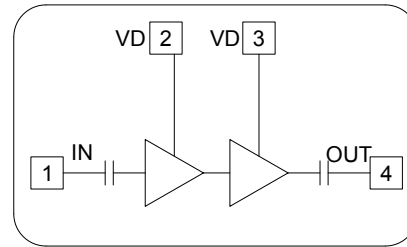


**特点:**

- 频率: 2~4GHz
- 增益: 29dB
- 输出-1dB 压缩点: 13Bm
- 单电源工作: +5V@45mA
- 工作温度: -55~+85℃
- 芯片尺寸: 1.2×1.24×0.1mm

**功能框图**

**性能参数: (T<sub>A</sub>=+25℃, VD=+5V, ID=45mA)**

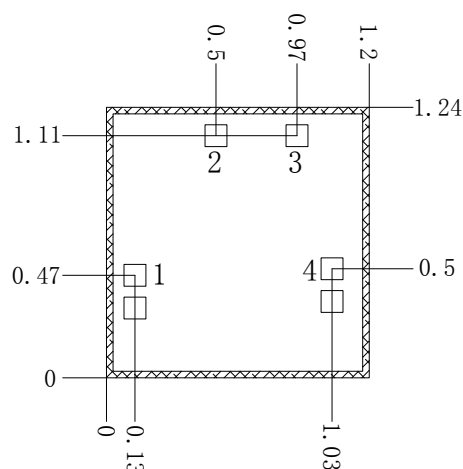
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注	
			MIN	TYP	MAX			
频率范围	f	VD=+5.0V Z <sub>in</sub> =Z <sub>out</sub> =50Ω	2		4	GHz		
增益	G		28	29		dB		
增益平坦度	ΔG			0.8	1	dB		
输入驻波	VSWR <sub>i</sub>				1.8	2.2		
输出驻波	VSWR <sub>o</sub>				1.8	2		
噪声系数	NF				1	1.2	dB	
输出 P <sub>-1</sub>	P <sub>-1</sub>			11	13		dBm	
输出 IP3	OIP3			22	24		dBm	
电压	VD			4.75	5	5.25	V	
电流	ID	VD=+5.0V		45	60	mA		

**极限参数表:**

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
最大输入电压	+6	V	最大输入功率	+18	dBm
贮存温度	-55~+150	℃			

**芯片尺寸图:**

单位: mm

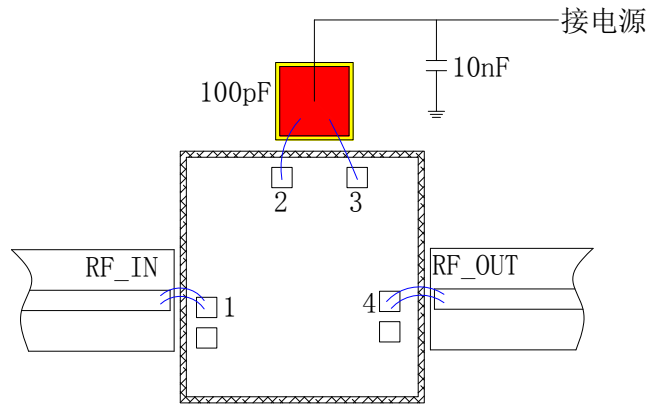


注: 典型键合焊盘尺寸为 100\*100um

**引脚定义:**

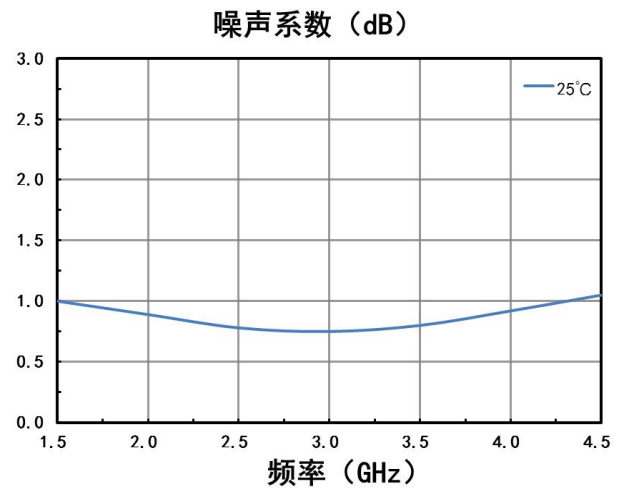
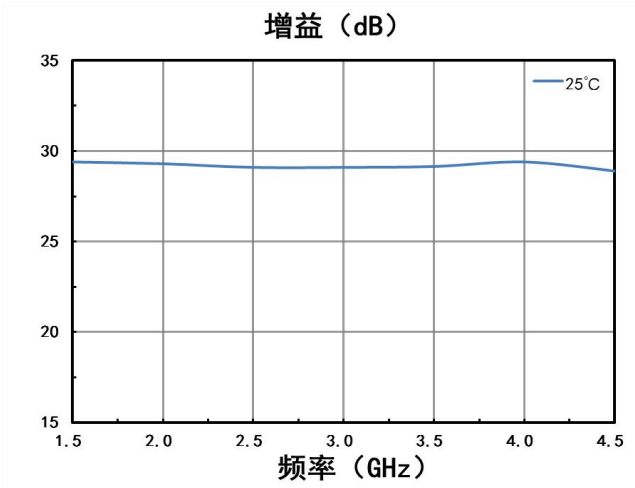
引脚	定义	描述
1	IN	射频输入, AC 耦合
2, 3	VD	放大器电源电压, 需外接 10nF 和 100pF 旁路电容
4	OUT	射频输出, AC 耦合
芯片背面	GND	芯片背面必须接至 RF/DC 地

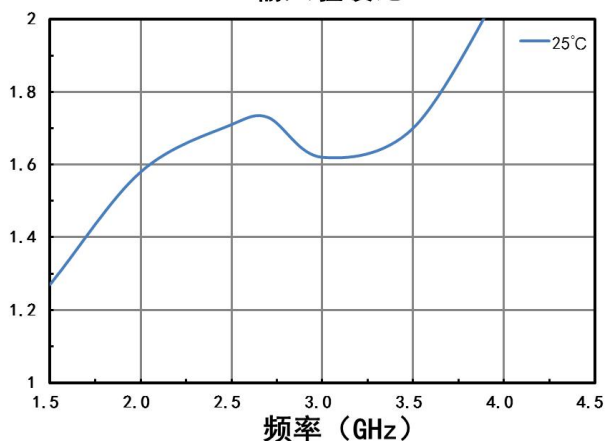
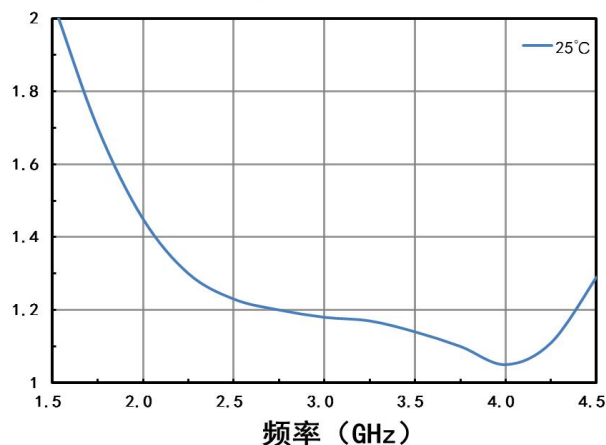
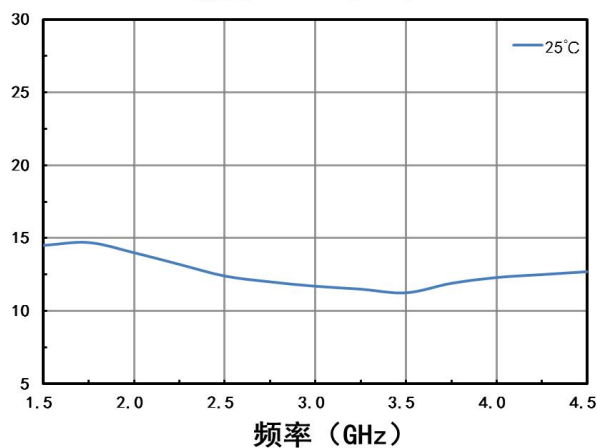
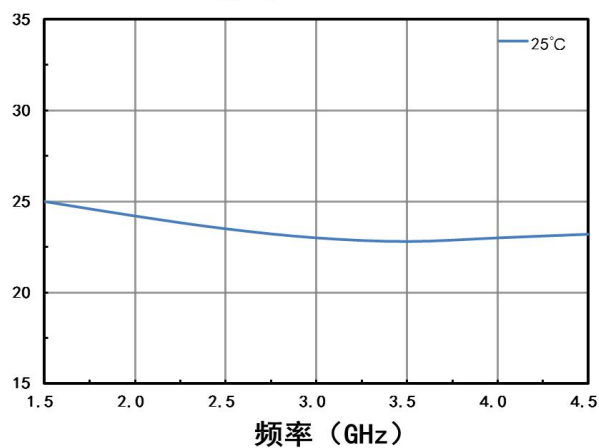
**推荐装配图:**



注: 未标注的键合焊盘不需要连接

**典型测试曲线:**



**输入驻波比**

**输出驻波比**

**输出P-1dB (dBm)**

**输出IP3 (dBm)**


### 产品使用注意事项:

1. 本芯片产品需要在干燥、氮气环境中存储，在超净环境装配使用；
2. 裸芯片使用的 GaAs 材料较脆，芯片表面容易受损，不能用干或湿化学方法清洁芯片表面使用时必须小心；
3. 芯片底部用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 295℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与微带线间歇不超过 3 mil，使用 1 mil 双金丝键合，其他端口使用 1 mil 单金丝，建议金丝长度 10~16 mil；
5. 产品对静电敏感，在存储和使用过程中注意防静电；
6. 其他使用说明详见《裸芯片产品使用说明》。